

SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURE

PUB. NO.: 54-040569 [JP 54040569 A]

PUBLISHED: March 30, 1979 (19790330)

INVENTOR(s): ODATE MITSUO

NISHIUCHI TAJI

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

APPL NO.: 52-107459 [JP 77107459]

FILED: September 06, 1977 (19770906)

INTL CLASS: [2] H01L-023/48; H01L-021/58

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)

JOURNAL: Section: E, Section No. 113, Vol. 03, No. 61, Pg. 92, May 26, 1979 (19790526)

ABSTRACT

PURPOSE: To make excellent contact by pressure-holding an semiconductor element by interposing oil or grease containing powdery metal between the main electrode of the element and an external electrode.

09日本国特許庁

10特許出願公開

公開特許公報

昭54-40569

50Int. Cl.²
H 01 L 23/48
H 01 L 21/58

識別記号 52日本分類
99(5) C 11

序内整理番号 43公開 昭和54年(1979)3月30日
7357-5F
7357-5F 発明の数 2
審査請求 未請求

(全 5 頁)

51半導体装置およびその製造方法

①特 願 昭52-107459
②出 願 昭52(1977)9月6日
③発 明 者 大館光雄
伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱
電機株式会社北伊丹製作所内

72発 明 者 西内泰治
伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱
電機株式会社北伊丹製作所内
76出 願 人 三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目2
番3号
74代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

明 四 口

1. 発明の名称

半導体装置およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 2つの主電極と1つ以上のp-n接合を有した半導体素子。前記半導体素子の各主電極に電気的、熱的にそれぞれ加圧供給された外部電極から形成された加圧供給形半導体装置において、前記半導体素子の少なくとも1つの主電極と前記外部電極との間に封入合金を混入した油またはグリースを介在させ加圧保持したことを特徴とする半導体装置。

(2) 2つの主電極と1つ以上のp-n接合を有した半導体素子。前記半導体素子の各主電極に電気的、熱的にそれぞれ加圧供給された外部電極から形成された加圧供給形半導体装置の製造方法において、前記半導体素子の少なくとも1つの主電極と前記外部電極との間に封入合金を混入した油またはグリースを介在させ、あらかじめ最終加圧保持圧力以上の圧力を少なくとも1回以上加圧し、

その後、加圧を徐々に減じて最終加圧保持圧力にして保持させることを特徴とする半導体装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

この発明は、半導体素子の主電極と、これに圧着された主電極体の外部電極間の電気的、熱的接触抵抗を減少させた半導体装置およびその製造方法に関するものである。

半導体素子の大型化に伴い合金間、特に半導体素子の主電極と、これに圧着される外部電極間との電気的、熱的接触抵抗を減少させることが問題となる。これらの接触抵抗を減少させるには、従来、半導体素子をラッピングして、平面度、平行度を向上させたり、半導体素子と外部電極との間に薄い合金、例えば、合金の板を挿入したり、圧着力を大きくする方法が行われていた。半導体素子は1つ以上のp-n接合をもつたシリコン円板と、それと熱圧接接触の類似した合金、例えばセリフデン、タンタムシリコンの支持板とを、シリコン等のろう材を用いて真空中、互に性ガ

スあるいは不活性ガス中で焼成してろう付けおよび合金が行われ形成される。

ところで、半導体素子の大口径化に伴い、半導体素子の径も85~100mmにもなり、シリコン板と支持板とろう付け、合金を行つたとき、シリコン板の周縁部に大きなストレスが残り、それが半導体素子の電気特性を阻害したり、各材料の熱膨張差によるバイメタル作用により、半導体素子の大きく反る等の問題が発生する。特に大口径の半導体素子の電気特性を改善するためには、シリコン板のストレスを断力軽減する必要がある。ストレスを軽減させるためにはシリコン板の曲げおよび厚みに適合させて、支持板の厚みを厚くすることにより解決することができると。しかしながらこれは半導体素子の反りのより増大を招くことになり、そのまま(ろう付け、合金完了)の状態では圧接力を加えて半導体素子と外部電極とを接触させようとする、シリコン板の反りを矯正する過程においてシリコン板内部のストレスの変動、ひいてはシリコン板内部でのクラックの発生を招

き、電気特性を劣化させてしまう。これについてさらに第1図を用いて説明する。

第1図は半導体装置の断面図を示すものである。この図で1は平形ダイオード等の半導体素子であり、 p と p^+ 接合を有するシリコン板2がシリコン板2を接合するセリブゲンからなる支持板3にアルミニウム-アルミニウムシリコン共晶層4によつてろう付けされ接合されている。5はアルミニウム層により形成されたアルミニウム電極であり、以上で半導体素子1が形成されている。この半導体素子1は上、下に電気、熱を取り出すための剛からなる第1の外部電極6と第2の外部電極11とが配置され、圧接状態で保持される。7はセラミックスあるいはガラス等からなる基板絶縁体であり、一方の端は第1の外部電極6に剛からなるダイヤフラム8がろう付けされ、他方の端は鉄-ニッケル合金からなる腐蝕リング9がろう付けされて、以上で第1の主電極体10が形成される。腐蝕リング12は第2の外部電極11とろう付けされる。13は腐蝕部分を示す。以上で第2の主

電極体14が形成される。15は冷却フィンである。

一般的には、各々の外部電極6、11は、平面度、平行度は20 μ m以下で表面粗さは10 μ m以下の加工が行われており、さらにニッケル、銅、銀、金メッキが5 μ m位施されている。

この半導体装置を組立てるには、先ず第1の主電極体10に半導体素子1を挿入し、次に第2の主電極体14をかぶせて、不活性雰囲気中で各々の腐蝕リング9、12をアークまたは抵抗加熱にて腐蝕が行われて半導体装置が完成する。このように組立てられた半導体装置に、さらに両電極の外部に熱および電気を取り出し、かつ、熱を冷却する冷却フィン15が圧接力Pで圧接される。

このように形成された半導体装置は半導体素子1の大口径化により、前述のように半導体素子1の反りも大きくなり圧接力Pによつて、反りが矯正されることにより発生するシリコン板2のストレスの増大ひいては、クラックの発生により半導体素子1の電気特性が劣化し、ひどいときには破

壊する事態が出る。また、反りを矯正させる圧接力Pが不足した場合は熱的特性が悪くなり、半導体素子1を劣化、破壊させる。そのための対策は第2図(a)に示す半導体素子1を第2図(b)、(c)、(d)のような方法において、これらの問題発生を抑えている。すなわち第2図(b)のようにラッピングにより平面度、平行度を小さくするか、第2図(c)のように表面に系かくて電気・熱伝導の良い金、銀等の貴金属層を設ける。さらには第2図(d)のように圧接力Pを α 倍して大きくする等の方法である。

しかし、第2図(b)のように鍍金層をラッピングすることは、その作業に必要ない時間と、大きな設備投資が必要となり、さらには労力と工数の増加につながり、また、ラッピング液の半導体素子表面の汚染・除去に神経を使うことになる。次に、第2図(c)のように貴金属層を設けることは、反りの増大にともない厚みも厚くなり、材料費の上昇につながる。さらに、第2図(d)のように圧接力を大きくすることは半導体装置の機械的

強度の増加に伴い、半導体装置の崩壊を大きくする原因となり好ましくない筈、いずれの方法にも多くの問題があつた。

この発明は、上述の点にかんがみなされたもので、大きく反りの発生している半導体素子に小さな圧力力によつて、電気特性、熱特性を充分満足させ、かつ半導体装置を構成する半導体素子の各主電極とこれに圧接する各々の外部電極とが良好な接触が得られ、さらばコスト、工費の増加、装置の大形化を伴わないようにしたものである。以下この発明について説明する。

第3図はこの発明の一実施例を示す断面図で、第1図と同一符号は同一部分を示し、10は前記半導体素子1の大きな反り部に介在させた粉末金属を塗布した油またはグリースである。このように油またはグリースを介在させることにより、第2図(a)、(b)、(c)で説明した従来との不適合をことごとく除去することができる。

第3図の半導体装置の組立ては、半導体素子1の主電極と各々の外部電極6、11と接触する部

は1.1以上の因子)をかけたときである。さらに第4図(c)は、最終加圧圧力 P' のときであるが、第4図(b)の $\alpha \cdot P'$ より圧力を徐々に低減したものであり、この圧力 P' で半導体装置の動作が行われる。ここでいう圧力 P' は 9.9 kg/cm^2 以下であり、 α は半導体素子1の口径と反り、各々の外部電極6、11の材質、熱膨張および歪曲率、ノック等の要因等によつて決められる定数であるが実験によれば2.5以上は越えなかつた。

次に油またはグリース10の状態を説明すると、第4図(a)では半導体素子1と各々の外部電極6、11間には、油またはグリース10が存在し、第4図(c)では徐々に圧力 $\alpha \cdot P'$ を低減して最終保持圧力 P' に至ると、半導体素子1の反りが部分的に平らになり、半導体素子1と各々の外部電極6、11間に空間ができるが、油またはグリース10の反り力により、この空間部に油またはグリース10が回り、この部分でも電気、熱の伝導が行われ、その結果、最終熱抵抗値および最終電気抵抗値(最終圧降下)が従来に比べて各々15%と

分のみの向面に油またはグリース10を塗布する。この際、図4図以外の部分に塗布することは、熱伝導の観点から充分考慮して行う必要がある。次に従来の同じように第1の主電極10と半導体素子1を挿入してから第2の主電極14をかぶせて、各々の外部リング9、12の部材を1つした後、内外部電極6、11に冷却フィン15が圧力 P' で圧接される。

このように組立てられた半導体装置は油またはグリース10を塗布した以外は従来のものと同一である。しかしながら、同じ圧力 P' においては、装置の最終熱抵抗値、最終電気抵抗値は従来に比べて各々10%と減少した。第5図に第4図(a)、(b)、(c)のそれぞれの熱抵抗と電圧降下の関係を示す。さらに、最終熱抵抗値および最終電気抵抗値を減少させるには、第4図に示した工程を行えばよい。

すなわち、第4図(a)は組立てられたままの圧力 $P=0$ のときである。第4図(b)は最終加圧圧力 P' の1.1倍以上の圧力つまり $\alpha \cdot P'$ (α

は1.1以上の因子)をかけたときである。また油またはグリース10中に入れる粉末金属の粒子の大きさと、熱抵抗、電圧降下の関係を第6図に示す。

すなわち、第5図において、図1は熱抵抗と電圧降下を示し、図2は規定圧力である。図3は熱抵抗、図4は電圧降下の圧力に対する変化を反している。

また第6図は図1に粉末金属の粒子径をとり、図2は第5図と同じく熱抵抗と電圧降下をとつたもので、図3は熱抵抗、図4は電圧降下を反する。第6図における粉末金属はよく知られたアルミニウム粉を用いたが、実験では比較的低く、かつ、反応 H_v 40以下の炭、インジウム、鉛、銅、亜鉛等の単一金属または合金を風でもさしつかえないことが判明している。この実験より、粉末金属の粒子の径は、半導体素子の反りの $1/10$ 以下であれば、大きな効果が見られる。

なお、上記実施例では半形ダイオードについて説明したが、この発明はこれに限定されるもので

なく、サイリスタ、トライアック、トランジスタ等の半形、スタッド形の半導体素子にも応用できることはいうまでもない。

以上説明したようにこの発明によれば、半導体素子と外部電極との圧接力を小さくすることができ、半導体装置に冷却体を取付ける機構が小形化されることはいうまでもなく、最終加圧圧接力が小さいために半導体素子の反りを無理に矯正することがないので、半導体素子を構成するシリコン板の外側部に発生するストレスも減少でき、断続的な動作における疲労の蓄積によるクラックも防げ、電気的特性の劣化が再生しない半導体装置が得られる利点がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の半導体装置の断面図、第2図(a)～(d)は第1図の半導体素子の反りを改善させる従来の方法の説明図、第3図はこの発明の一実施例を示す半導体装置の断面図、第4図は油圧力による半導体素子外部電極間の油またはグリースの接触状態の説明図、第5図は、第4図の過程にお

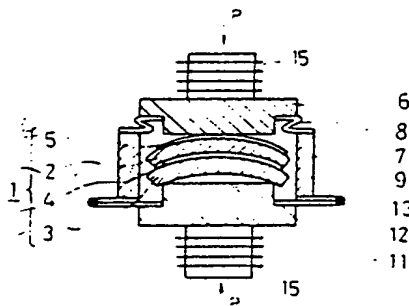
特開昭54-10569(4)

ける電気・熱特性の図面図、第6図は油またはグリースに浸入される粉末金属粒子(アルミニウム)と電気・熱特性の図面図である。

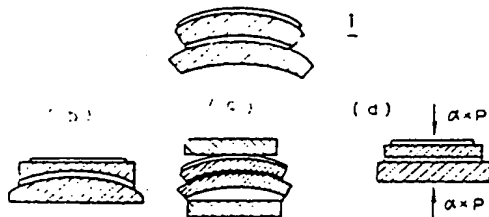
図中、1は半導体素子、2はシリコン板、3は支持板、4はアルミニウム-アルミニウムシリコン共晶層、5はアルミニウム電極、6は第1の外部電極、7は環状絶縁体、8はダイヤモンド、9、12は冷却リング、10は第1の主電極体、11は第2の外部電極、13は冷却部分、14は第2の主電極体、15は冷却フィン、16は油またはグリースである。なお、図中の同一符号は同一または相当部分を示す。

代理人 馬 野 信 一 (外1名)

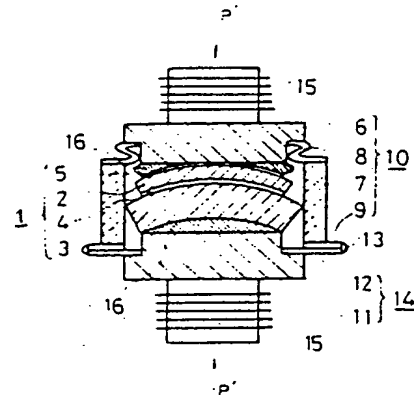
第 1 図



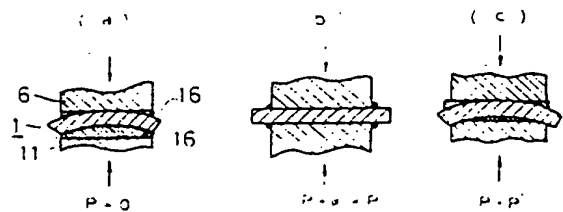
第 2 図



第 3 図

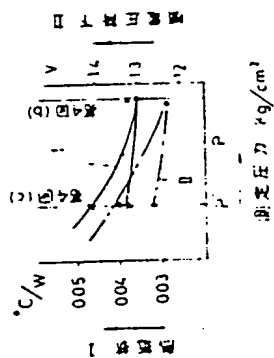


第 4 図



1825

第 5 図



第 6 図

